



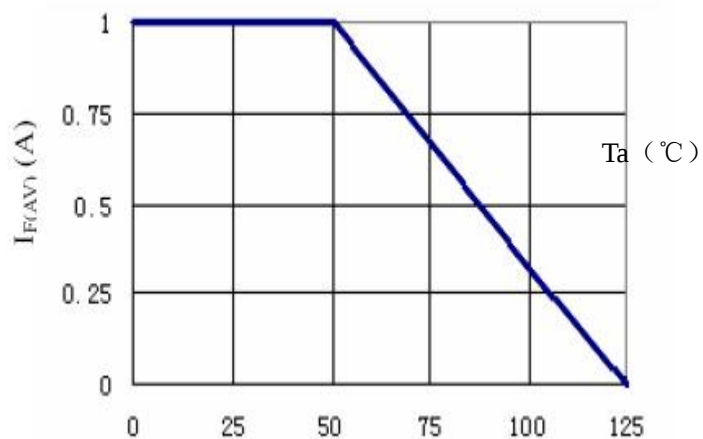
1. 产品名称： 高压二极管
Name: High Voltage Diode
2. 适用范围： 本规格书适用于 HVP-16 型高压二极管
Range: HVP-16 High Voltage Diode
3. 概要：
Outline
 3. 1 类型： 硅整流二极管
Type: Silicon diode
 3. 2 结构： 环氧树脂封装
Structure: Molded by epoxy resin
4. 绝对最大值 Absolute Max. Rating

序号 No.	项目 Item	符号 symbol	数值 Rating	单位 Unit	条件 Conditions
1	反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverses	V_{RRM}	16	KV	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_R=0.5\mu\text{A}$
2	反向工作峰值电压 Peak Working Revere Voltage	V_{RWM}	16	KV	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_R=0.5\mu\text{A}$
3	反向不重复峰值电压 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	17.6	KV	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_R=0.5\mu\text{A}$
4	最高结温 Maximum Junction Temperature	T_{jmax}	120	$^{\circ}\text{C}$	
5	贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +120	$^{\circ}\text{C}$	
6	平均正向电流 Average Forward Current	I_O	1.0	A	正弦半波 50Hz, 电阻负载, $T_{break}=75^{\circ}\text{C}$
7	正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current	I_{FSM}	50	A	正弦半波持续时间 0.01S 50Hz

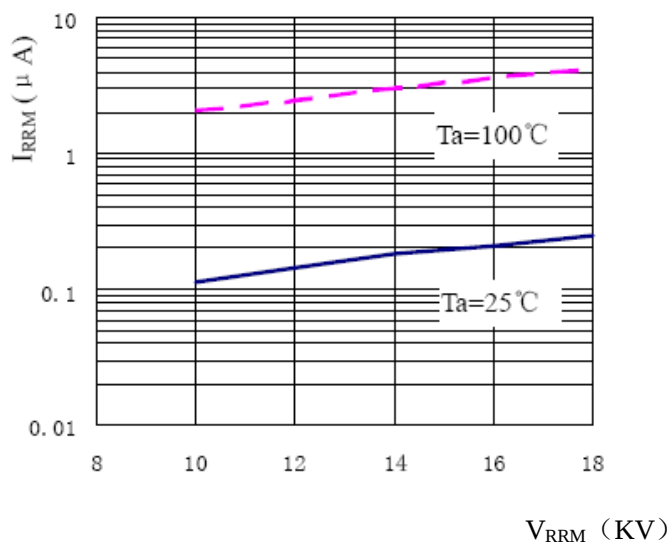
5. 电特性 Electric characteristic (if no other require, Tamb=25℃)

序号 No.	项目 Item	符号 symbol	数值 Rating	单位 Unit	条件 Conditions
1	常温反向漏电流 Normal Temperature Reverse Current	I_{RRM1}	5.0 max	μA	$V_R=V_{RRM}$ $T_{amb}=25^{\circ}C$
2	高温反向漏电流 High Temperature Reverse Current	I_{RRM2}	50.0 max	μA	$V_R=V_{RRM}$ $T_{amb}=100^{\circ}C$
3	正向电压 Reverse Breakdown Voltage	V_F	24.0	V	$I_F=1.0A$

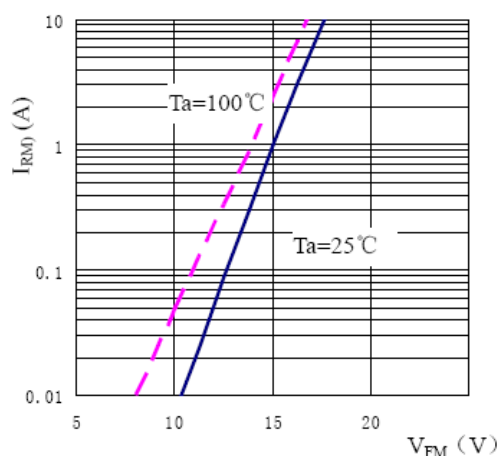
6. 特性曲线 Characteristic Curve



Forward average current derating curve

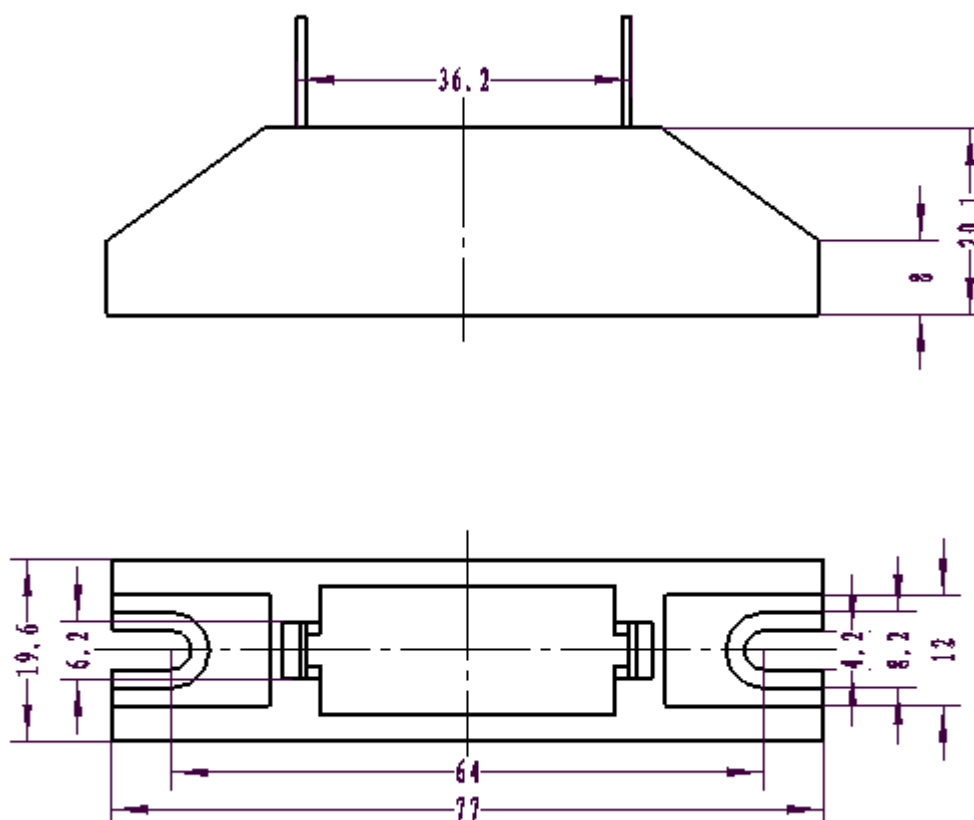


Reverse voltage characteristics curve



Forward voltage characteristics curve

7. 外形图示 Outline Dimension



8. 材料 Materials

NO	名 称 Name	材 料 型 号 Types of materials
1	正极端子 Male terminal	Φ 2.0 镀银(锡)插片 / Φ 2.0 silver (tin) plating filling-in pits
2	负极端子 Female terminal	Φ 4.0 镀银(锡)插片 / Φ 4.0 silver (tin) plating filling-in pits
3	封装 Package	环氧树脂 / Epoxy resin
4	芯片 Chip	硅 / Silicon